

# ЭТИКЕТКА



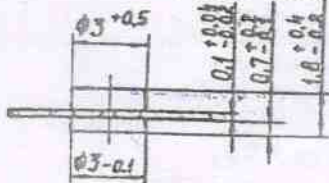
Транзистор типа 2Т642А-2  
соответствует

техническим условиям

№0.339.112 ТУ

Дата изготовления

2008 08  
( год, месяц )



Масса не более 0,2 г

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	в 1000 шт. транзисторов (г)	в том числе на выводках	
		Удельный расход металла на единицу длины вывода (г/мм)	Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
золото	2,340	0,00009	Зл 3
серебро	0,900		

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при  $t_{кр} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Примечание
		по метке	по базе	
Обратный ток коллектора, мА ( $U_{кб} = 20\text{ В}$ )	$I_{ксо}$		1	
Обратный ток эмиттера, мА ( $U_{эб} = 2\text{ В}$ )	$I_{эсо}$		0,1	
Выходная мощность (среднее значение), мВт ( $U_{кб} = 12\text{ В}$ , $I_{к} = 45\text{ мА}$ , $f = 8\text{ МГц}$ , $P_{эл} = 40\text{ мВт}$ ) $t_{кристалл} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$	$P_{вых\text{ ср}}$	100		
Фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей базой на высокой частоте, градус ( $f = 1\text{ МГц}$ , $U_{кб} = 5\text{ В}$ , $I_{к} = 30\text{ мА}$ , $t_{кристалл} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$ )	$\arg(h_{21б})$		19	1
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой, ( $U_{кб} = 5\text{ В}$ , $I_{к} = 30\text{ мА}$ , $f = 100\text{ МГц}$ , $t_{кристалл} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$ )	$ S_{12б} $		$1,8 \cdot 10^{-3}$	2
Коэффициент полезного действия коллектора (среднее значение), % ( $U_{кб} = 12\text{ В}$ , $I_{к} = 45\text{ мА}$ , $f = 8\text{ МГц}$ , $P_{эл} = 40\text{ мВт}$ ) $t_{кристалл} = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$ )	$\eta_{к\text{ ср}}$	18		

Примечания.

1. Фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей базой на высокой частоте связана с граничной частотой коэффициента передачи тока соотношением:

$$f_{гр} (\text{МГц}) = \frac{57,3}{\arg(h_{21б})}$$

где  $f$  - частота, на которой измеряется  $\arg(h_{21б})$ .

2. Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой  $|S_{12б}|$  - отношение напряжений отраженной волны на входе транзистора к напряжению падающей волны на выходе транзистора, включенного в согласованный СВЧ трект связи с постоянной времени цепи обратной связи соотношением:

$$\tau_k = \frac{|S_{12б}|}{4\pi f}$$

где  $f$  - частота, на которой измеряется  $|S_{12б}|$ .

Место для штампа  
ОП

Место для штампа  
представителя заказчика